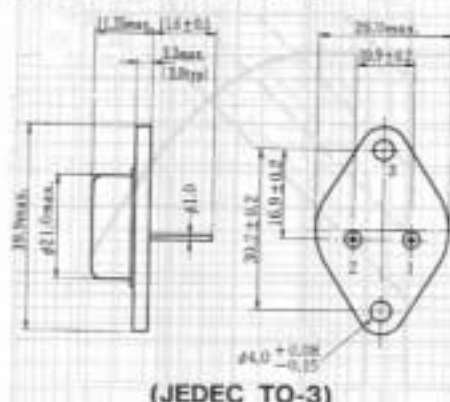


2SJ112

シリコン P チャンネル MOS FET

高速度電力スイッチング用
高周波電力増幅用
2SK398 とコンプリメンタリペア

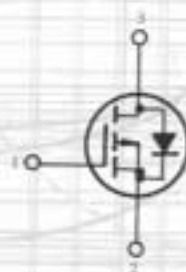


(JEDEC TO-3)

1. ゲート: Gate
 2. ソース: Source
 3. ドレイン: Drain
- (ケース) (Case)
(Dimensions in mm)

SILICON P-CHANNEL MOS FET

HIGH SPEED POWER SWITCHING
HIGH FREQUENCY POWER AMPLIFIER
Complementary pair with 2SK398



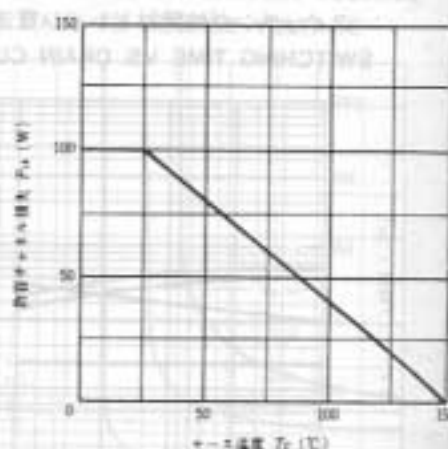
■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	2SJ112	Unit
ドレイン・ソース電圧	V_{DS}	-100	V
ゲート・ソース電圧	V_{GS}	± 20	V
ドレイン電流	I_D	-10	A
せん断ドレイン電流	$I_{D(max)}$	-15	A
通ドレイン電流	I_{DS}	-10	A
許容チャネル損失	P_{ch}	100	W
チャネル温度	T_{ch}	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

- $T_c = 25^\circ\text{C}$ における許容値
- Value at $T_c = 25^\circ\text{C}$

許容チャネル損失のケース温度による変化

MAXIMUM CHANNEL DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
ドレイン・ソース破壊電圧	$V_{(BR)DS}$	$I_D = -10\text{mA}$, $V_{GS} = 0$	-100	—	—	V
ゲート遮断電流	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20\text{V}$, $V_{DS} = 0$	—	—	± 1	μA
ドレイン電流	I_{DS}	$V_{DS} = -80\text{V}$, $V_{GS} = 0$	—	—	1	mA
ゲート・ソース遮断電圧	$V_{GS(off)}$	$I_D = -1\text{mA}$, $V_{DS} = -10\text{V}$	-2.0	—	-5.0	V
ドレイン・ソースオン抵抗	$R_{DS(on)}$	$I_D = -5\text{A}$, $V_{GS} = -15\text{V}^*$	—	0.25	0.35	Ω
ドレイン・ソース飽和電圧	$V_{DS(sat)}$	$I_D = -5\text{A}$, $V_{GS} = -15\text{V}^*$	—	-1.25	-1.75	V
順伝達アドミタンス	$ y_{fs} $	$I_D = -5\text{A}$, $V_{DS} = -10\text{V}^*$	1.5	2.0	—	S
入力容量	C_{iss}	$V_{DS} = -10\text{V}$, $V_{GS} = 0$	—	1100	—	pF
出力容量	C_{oss}	$f = 1\text{MHz}$	—	650	—	pF
逆伝達容量	C_{rss}		—	90	—	pF
ターンオン遅延時間	$t_{d(on)}$		—	20	—	ns
立上り時間	t_r	$I_D = -2\text{A}$, $V_{GS} = -15\text{V}$, $R_L = 15\Omega$	—	50	—	ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(off)}$		—	90	—	ns
下降時間	t_f		—	70	—	ns
ダイオード順電圧	V_{DF}	$I_F = -5\text{A}$, $V_{GS} = 0$	—	-0.9	—	V
逆回復時間	t_{rr}	$I_F = -5\text{A}$, $V_{GS} = 0$	—	350	—	ns

- パルス測定
- Pulse Test